

Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0121U108529

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-02-2021



II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 654 1030

У тому числі по роках:	
2021	12149.865 тис. грн.
2022	19477.145 тис. грн.
2023	17749.761 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 49376.771 тис. грн.	

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442343243

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: проспект Науки, буд. 41, м. Київ, 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020, 380445258342

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Створення базових технологій формування напівпровідникових матеріалів і структур для нано- та оптоелектроніки

Назва роботи англійською:

Creation of basic technologies for the formation of semiconductor materials and structures for Nano - and optoelectronics

Мета роботи українською:

Проведення прикладних досліджень з метою вирішення актуальних проблем сучасного напівпровідникового матеріалознавства, створення в ІФН НАН України базових технологій отримання матеріалів і структур, що є затребуваними: в сучасних оптоелектронних та сенсорних пристроях, для забезпечення розвитку сучасних діагностичних методів, удосконалення існуючих і створення нових джерел живлення та випромінювання.

Мета роботи англійською:

Conducting applied research in order to solve actual problems of modern semiconductor materials science, creating basic technologies for obtaining materials and structures in the IFN of the National Academy of Sciences of Ukraine, which are in demand: in modern optoelectronic and sensor devices, to ensure the development of modern diagnostic methods, improving existing and creating new power and radiation sources.

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Нові речовини і матеріали

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Технології; Методи, теорії

Галузь застосування: оптоелектроніка, сонячна енергетика, НВЧ-, ТГц-, ІЧ-фотоелектроніка

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Мельник Віктор Павлович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Створення базових технологій формування напівпровідникових матеріалів і структур для нано- та оптоелектроніки

Початок етапу: 01.2021

Закінчення етапу: 12.2023

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 621.315.562, 621.38.049.77, 621.315.592

Коди тематичних рубрик: 45.09.35, 47.33.33, 47.09.29

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Мельник Віктор Павлович

д. ф.-м. н., 01.04.10

Назаренкова Т.І.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

+38 (044) 525-60-40

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

Юрченко Т.А.

